# Nanoelectronique de charge

# **Dominique Mailly**



FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE







# Des domaines d'action ont été identifiés pour lesquels les compétences et les forces sont réunis sur le plateau et permettront de rapides avancées

- Transport quantique cohérent (forte interaction avec PALM)
- Nanofils semiconducteurs
- Nanodispositifs à base de carbone
- Théorie&modélisation



# **Nanofils semiconducteur**

- La faible dimension permet une relaxation des contraintes et ouvre accès à des combinaisons de matériaux inédits ayant des très forts désaccords de maille.
- Système unidimensionnel cristallin pratiquement exempt de défauts (cf top down gravure).
- Possibilités de croissance d'hétérostructures axiale et/ou radiale : boite quantique, gaz d'électron cylindrique, .... Ouvre des perspectives de couplages électrons photons et de leurs manipulations de l'un par l'autre.
- Par dépôt contrôlé de catalyseur ou ouverture de masque on peut localiser la croissance d'un nanofils unique et par la suite le contacter pour en mesurer ses propriétés électriques



## Une grande variété de structures

#### Heterostructure axiale



Super-réseau GaP/GaAsP

#### Heterostructure radiale



#### InAsP/InP coeur coquille



## AlGaAs/GaAs nanofils coeur/coquille

700



- > dépôt du catalyseur (ebeam litho)
- Croissance axiale : croissance du coeur en GaAs
- Croissance radiale : coquille AlGaAs (+ couche Si dopage)
- Croissance 2D : enterrement en GaAs







### Qualité cristallographique des nanofils coeur/coquille





## Mesure de transport





NanoSaclay -

## Nanotube de Carbone et graphène

Le graphène : une structure de bande très particulière





Deux atomes par maille:pseudo spin



# **Applications du Graphène**



## il faut un matériau de bonne qualité et homogène sur de grandes surfaces



# **Travail sur la croissance**

#### Épitaxie sur SiC CVD sur métaux H $CH_{4}$ P ≈ 5.10 -5 Torr Si from the gas phase Argon High Si partial pressure sublimatio oressure pha $\rightarrow$ Low sublimation rate Gas ī Graphene monolayer ------

Ces deux méthodes compatibles grandes dimensions donnent pour l'instant des couches avec trop de défauts



# **Travail sur la modélisation**

- Comprendre le rôle des défauts structuraux
- Comprendre la présence et le rôle des « dopants » indésirables
- Modéliser plusieurs couches
- Modifier la géométrie pour ouvrir un gap (nanoruban)
- Modéliser l'injection de spin car temps de cohérence de spin très long.
- Comprendre la distribution des charges en présence de potentiel



### Transport polarisé en spin dans les nanorubans de graphène

Un plan de graphène est semi-métallique (gap nul)

→ Découpé en nanorubans, il peut devenir semi-conducteur

 $\rightarrow$  Potentiel pour dispositifs nanoélectroniques et spintroniques (longueur de relaxation de spin > 1,5 µm)



#### Contrôle efficace de la polarisation de spin si la qualité des bords est maitrisée

(simulation quantique atomistique par fonctions de Green et liaisons fortes)

Nguyen et al. J. Appl. Phys. 2009



## Calcul d'oscillation de charge induite par un potentiel externe



Le Labex s'appuie sur des moyens d'exception

Deux centrales de technologies : IEF& LPN

Des grands instruments : SOLEIL, LLB

Microscopie électronique : LPS, LPN, X (TEMPOS)

